(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平7-72491

(43)公開日 平成7年(1995)3月17日

(51) Int.CL.6

織別記号 广内整理番号

ΡI

技術表示箇所

G02F 1/1343

審査請求 未請求 語求項の数16 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号	特顧平6-24072	(71)出廢人	000005108
(22)出版日	平成6年(1994)2月22日	(m) specime	株式会社日立製作所 京京都千代田区村田駿河台四丁目 6 番池
(31)優先機主張番号	特額平5-164398	(72)発明者	茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
(32)優先日	平5 (1998) 7月2日		式会社日立製作所日立研究所內
(33)優先權主張国	日本(JP)	(72) 発明者	·
•			表域県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
		(72) 発明者	忘村 正人
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(74)代理人	弁理士 高機 明夫 (外1名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 単純マトリクス型液晶表示装配

(57)【要約】

【目的】表示の均一性が高く、視角特性が良好な単純マトリクス型液晶表示装置の提供にある。

【構成】少なくとも一方が透明な一対の基板間に、誘電 異方性を有する液晶組成物層、n×m個のマトリクス状 の画素を形成する電極群、液晶分子の配向を制御する配 向制御膜、基板間隔を一定にするスペーサを挟持して成 る液晶素子、前記液晶分子の配向状態に応じて光学特性 を変える手段、所定の電圧液形を発生させるLSI配動 回路を有し、各画素内の前記液晶組成物層に電界を印加 する電極が定査電極群と信号電極群で構成されている単 純マトリクス型液晶表示装置であって、前記両電極群が 前記液晶組成物層に対し前記基板面に実質的に平行な電 界を印加するよう構成されている。 (2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方が透明な一対の基板間に、誘電具方性を有する液晶組成物層。n×m個のマトリクス状の回素を形成する電極群、液晶分子の配向を制御する配向制御機、基板間隔を一定にするスペーサを挟持して成る液晶素子、前記液晶分子の配向状態に応じて光学特性を変える手段、所定の電圧液形を発生させるし、SI駆動回路を有し、各画素内の前記液晶組成物層に電界を印加する電極が走査電極群と信号電極群で構成されている単純マトリクス型液晶表示装置であって、

前記両電極器が前記液晶組成物層に対し前記基板面に実 質的に平行な電界を印加するよう構成されていることを 特徴とする単純マトリクス型液晶表示装置。

【語求項2】 前記両電極群は、互いに交差するn本の Y電極とm本のX電極とで構成されたマトリクス電極で あり、前記Y(またはX)電極はストライブ状電便であ り、X(またはY)電極がストライブ状の部分Iと、隣 接するY(またはX)電極間に在って、かつ、Y(また はX)電極と実質的に平行な部分IIとを有する電便で構 成されている語求項1に記載の単純マトリクス型液晶表 示義圖。

【請求項3】 前記X(またはY)電極のY(または X)電極と実質的に平行な部分IIが、1 画素中に複数個 形成されている請求項2に記載の単純マトリクス型液晶 表示装置。

【語求項4】 前記X(またはY)電極のY(または X)電極と実質的に平行な部分IIにより複数個に分割された各分割回素が長方形或いは細長い形をしており、かつ。電界の印加方向がその短辺方向に実質的に平行である語求項2または3に記載の単純マトリクス型液晶表示 30 装置。

【請求項5】 前記駆動回路は走査回路と信号回路とからなり、前記走査回路の走査複数が40本以下である請求項1~4のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【語求項6】 前記級動回路は走査回路と信号回路とからなり、前記信号回路が少なくとも二系統に分けられている語求項1~5のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項7】 前記基板の少なくとも一方が、液晶組成 40 物層と接していない面に駆動信号を任達するための電極を有し、前記電極は液晶組成物層に電界を印加する電極と基板に設けられたスルーホールを介して接続されている請求項1~6のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項8】 前記X電極と前記Y電極が前記基板の一方に配置され、X電極とY電極間は電気的に絶嫌されている請求項1~7のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項9】 前記X電極およびY電極がいずれも低電 50

2 気抵抗の金属で構成されている請求項1~8のいずれか に記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【語求項10】 前記X電極およびY電極が返光領域層を兼ねている語求項1~9のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項11】 前記X電極およびY電極が反射膜の一部を兼ねている請求項1~10のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項12】 前記X電優および/またはY電優が前 10 記スペーサを兼ねている請求項1~11のいずれかに記 載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項13】 前記基板の一方に各國素毎にカラーフィルタが設けられている請求項1~12のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【請求項14】 前記カラーフィルタがR, G. Bからなる請求項13に記載の単純マトリクス型液晶表示装

接する?(またはX)電極間に在って、かつ、?(また 【請求項15】 前記液晶組成物層の厚さすが3 μm以はX)電極と実質的に平行な部分IIとを有する電極で機 上、屈折率異方性立立が0、2以下で、かつ、それらの成されている請求項1に記載の単純マトリクス型液晶表 20 箱は・立立が0、2~1、2 μmである請求項1~14のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【語求項16】 前記配向制御膜の配向方向と印加電界の方向とのなず角が1~4度である語求項1~15のいずれかに記載の単純マトリクス型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表示の均一性が高く、 視角特性の優れた単純マトリクス型液晶表示装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置では、一般に液晶層に印削する電界は、2枚の基板面上に対向して配置した一対の透明電極により基板面対し垂直に電界を印削していた。そして、単純マトリクス型液晶表示装置においては、下側基板に領状のY電極(信号電極)を、上側基板に線状のX電極(定査電極)を形成し、文字等の表示はX、Y両電極の交点部にある液晶を点灯あるいは非点灯することにより行っていた。

【0003】 n本の走査電極をX,、X,、……Xnと 1ラインずつ線順次走査を繰り返す時分割駆動により、 あるいは複数の走査電極を同時に走査する複数線同時選 択駆動を行うことにより表示されていた。今、ある走査 電極が選択されたとき、そのX電極上のすべての画素に 信号電極であるY, Y, ……Ynより、表示信号に 基づき、選択または非選択の信号を同時に加える。この ように走査電極と信号電極に加える電圧パルスの組合せ で両者の交点(画素)の液晶が点灯または非点灯とな る。なお、上記において、走査電極Xの数が時分割数に 相当する。

[0004]

(3)

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記の従来技術においては、ITO (Indium Tin Oxide) に代表ののでは、比抵抗が(1.5~2.5)×10~ 複数の・cmと高く、そのために駆動しSIで発生した信号をした。前記透明電極を介して液晶層へ印加する際、印加信号波形が歪み、かつ、液晶層に実際に印加される電界が低下する。また、液晶表示素子素子面の左端と右端とで、印加される電界の大きさに差が生じる現象も起こった。これらによりコントラスト比(白表示透過率と黒表示透過率の比)の低下、表示むち、クロストーク現象が10。 る。発生して表示面質が低下すると云う問題があった。 (0)

3

【①①①5】クロストークとは、時分割駆動を行った場合。表示したくない非衰示点(非選択点)が完全に非衰示状態にならずに半衰示(半点灯)状態となり。表示回面全体のコントラスト比を低下させる現象を云う。これは液晶衰示装置の弱点であり、ある駆動電圧を設定した場合。非選択点にもバイアス電圧が印加されているため。当該部分の液晶が僅かに応答して透過率が上昇する。この状態の透過率と完全な非選択状態の透過率の差がクロストークと呼ばれる。

【0006】また、液晶表示素子を正面から見たとき斜めから見たときの輝度が大きく変化する視角特性の低下が生じ、表示品質の低下を紹くと云う問題もあった。

【0007】本発明の目的は、表示の均一性が高く、視 角特性が良好な単純マトリクス型液晶表示接置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成する本発明の要旨は次のとおりである。

【①①①9】(1) 少なくとも一方が透明な一対の基 30 板間に、誘電異方性を有する液晶組成物層、n×m個のマトリクス状の画素を形成する電極群、液晶分子の配向を制御する配向制御膜、基板間隔を一定にするスペーヴを終持して成る液晶素子、前記液晶分子の配向状態に応じて光学特性を変える手段、所定の電圧波形を発生させるし、SI駆動回路を有し、各画素内の前記液晶組成物層に電界を印加する電極が走査電極群と信号電極群で構成されている単純マトリクス型液晶表示装置であって、前記両電極群が前記液晶組成物層に対し前記基板面に実質的に平行な電界を印加するよう構成されている。 40

【0010】(2) 前記両電極器は、互いに交差する n本のY電極とm本のX電極とで構成されたマトリクス 電極であり、前記Y(またはX)電極はストライプ状電 極であり、X(またはY)電極がストライプ状の部分! と、関接するY(またはX)電極間に在って、かつ、Y (またはX)電極と実質的に平行な部分IIとを有する電 極で構成されている。

【①①11】望ましくは、前記X(またはY)電極のY(またはX)電極と実質的に平行な部分IIが、1 画素中に複数個形成されている。

【0012】更に望ましくは、前記X(またはY)電極ののY(またはX)電極と実質的に平行な部分IIにより複数個に分割された各分割画意が長方形或いは細長い形をしており、かつ、電界の印加方向がその短辺方向に実質的に平行である。

【0013】(3) 前記XおよびYのマトリクス電極 群のいずれもが、前記一対の基板の一方に配置されていると共に、XおよびYの電極群の間に電気的絶練層(S 101、好ましくは返明な有機ポリマ)が形成されている。

【①①14】(4) 前記駆動回路は走査回路と信号回路とからなり、前記信号回路が少なくとも二系統に分けて構成されている。

【0015】(5) 前記走査回路の走査線数を40本以下とする。

【①①16】(6) 前記墓板の少なくとも一方が、液 晶組成物層と接していない面に駆動信号を伝達するため の電極を有し、前記電極は液晶組成物層にכいまる る電極と基板に設けられたスルーホールを介して接続さ 20 れている。

【①①17】(7) 前記電極がいずれも低電気抵抗の 金属電極からなる。

【①①18】(8) 前記電極群が遮光層または反射膜を兼ねている。

【0019】(9) 前記X電極および/またはY電極が前記スペーサを兼ねている。

【0.020】(1.0) 前記液晶組成物層の厚さ d が 3 μ 加以上、層折率異方性 Δ Δ D が 0.2 Δ D である。

(6 【0021】(11) 前記配向制御機の配向方向と印 加電界の方向とのなす角が1~4度好ましくは2度以下 とする。

[0022]

【作用】図1(a)、(b)は本発明の液晶素子内での液晶の動作を示す模式側断面、図1(c)、(d)はその模式平面図である。通常はマトリクス状の電極により複数の回素を有するが、図1はその一回素の部分を示した。なお、電界無印加時を図1(a)、(c)に、また、電界印加時を図1(c)、(d)示す。

6 【0023】透明な一対の墓板3,3の内側に線状の電極1,2が形成され、その上に配向制御膜4が形成されている。基板3,3間に検持されている棒状の液晶分子5は、電界無印加時には線状電極1,2の長手方向に対して若干の角度を持つように配向されている。なお、この場合の液晶の誘電異方性は正を想定している。

【0024】次に、電界7を印加すると図1(b)、

(d)に示すように電界方向に液晶分子5はその向きを 変える。偏光板6を所定角度9に配置することで光透過 率を変えることが可能となる。このように本発明では透 50 明電極を用いなくともコントラストを与える表示が可能

特開平7-72491

(4)

となる。

【①①25】なお、基板3の表面に対する電界方向7の なす角は実際は20度以下で、実質的に平行であること が望ましい。以下、本発明では20度以下のものを総称 して平行電界と表現する。また、図1では電極1、2を 上下墓板に分けて形成した場合を示すが、一方の墓板に のみ電極1,2を形成してもその効果は変わらない。む しる電極のパターンが微細化し、熱、外力等による影響 を考慮すると、一方の基板に形成した方が高精度なアラ イメントが可能で好ましい。

【0026】(1)表示むらの低減

本発明では電極に低電気抵抗の金属電極が使用できるた め、駆動信号の液形歪を防ぎクロストークが起こりにく い。また、低電気抵抗の電極は液晶表示素子の左端と右 鑑とでの電界強度の差を小さくできるので、表示品質の 均一化にも優れている。

【0027】また、電界を基板面に平行に加えて表示す るため、液晶分子が基板面から立ち上がらないので、液 **晶分子のチルト角(液晶分子長輪と墓板とのなす角)を** 従来のように大きくする必要がない。電界を基板面に対 20 えることで表示するため、視角方向を変えても明るさの して垂直に印加される方式では、チルト角が不足すると 液晶分子が立ち上がった場合の傾く方向が異なる2状態 間およびその境界部にドメインが生じる。

【0028】本発明では、むしろチルト角よりもラビン グ方向を電界方向に対して()度(あるいは9()度)から ずらして設定すればよい。例えば、誘電率異方性が正の 液晶組成物を用いた場合。電界方向とラビング方向とが なす角を1~4度、好ましくは2度以下になるように設 定する。もし()度とすると、電界を印加したとき方向の 異なる2種の変形が生じ、異なる2状態間およびそれら 30 の境界部にドメインが生じる。

【0029】本発明では、チルト角が小さくともドメイ ンが生じないので低チルト角に設定することが可能であ る。液晶分子の配向の均一性は、低チルト角に設定する ほど良好である。従って、本発明では製造プロセスに変 動があっても、従来のものよりも表示むらを少なくする ことができる。

【0030】また、基板面とほぼ平行に電界を印加する 本発明においては、液晶分子の配向方向を基板界面に対 ラビングが不要となる。しかし、ドメイン発生を抑える にはチルト角は必要で、70~90度未満に設定すると

【0031】(2) 視角特性の向上

コントラストを付与する具体的構成としては、上下基板 界面上の液晶分子の長輪方向の配向がほぼ平行な状態を 利用したモード (復屈折モードと呼ぶ) と、上下基板界 面上の液晶分子の長輪方向が交差し、セル内での分子配 列が基板の上側から下側にねじれた状態を利用したモー ド(綻光性モードと呼ぶ)と、液晶分子配列をランダム「50」【0038】図1に示すように、下側蟇板3上に信号電

にした状態を利用したモード(散乱モードと呼ぶ)があ

5

【0032】上記復屈折モードでは、電界印加により液 晶分子長輪の方向が基板界面にほぼ平行なま、で方位を 変え、所定角度に設定された偏光板の軸とのなす角によ り光透過率を変える。旋光性モードも同様に電界印加に より波晶分子長軸方向の方位が変わるが、この場合はね じれ構造が解けることによる旋光性の変化を利用し、透 過光量や衰示色の色調を制御する。また、飲乱モードで 16 は、電界無印削時に液晶分子は基板界面に平行あるいは 金直に一様に配向しているものが、電界印加により液晶 分子がランダム配向となり光を散乱させることで光透過 率を変える。

【0033】従来の表示方式では電界の印加により液晶 分子の長輪方向を基板面に対して平行から垂直。あるい は垂直から平行に変化させたが、本発明の復屈折モード および旋光性モードでは、いずれも液晶分子の長軸は基 板と常にはく平行で立ち上がることがなく、液晶分子長 軸と偏光板の軸(吸収軸または透過軸)とのなす角を変 変化が小さく視角特性の上で優れている。また、散乱モ ードを適用した場合は、分子配向がランダムなため観角 方向による透過率の変化はない。

[0034]

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明する。 【りり35】先す初めに、電界方向に対する偏光板の偏 光透過輪のなす角々。、界面近傍での液晶分子長輪(光 学軸) 方向のなす角々。。 一対の偏光板間に挿入した位 相差板の進相軸のなす角の、の関係を図2に示す。な お、偏光板および液晶界面はそれぞれ上下で一対あるの で、必要に応じてあれ、ゆい、あいい、あいと表記す

【0036】〔実施例1〕墓板3としては表面を研磨し た厚さ1.1mmのガラス基板を2枚用いる。この基板 間に誘電率異方性Δεが正でその値が4.5. 復屈折率 **△nが0.072 (589 nm. 20℃) のネマチック** 液晶組成物を挟む。なお、基板表面にはポリイミド系の 配向副御膜4を塗布形成し、ラピング処理して3.5度 のプレチルト角とする。また、配向制御膜の上下のラビ して概略垂直とすることも可能であるが、この場合には 40 ング方向は互いにはく平行で、かつ、印加電界方向との なす角度を85度(か、こ、=か、こ、=85°) とした。ギ ャップdは鍬形のポリマビーズを基板間に分散、鋏持し て、液晶封入状態で4.5 mmとした。これにより An · dは0,324 umである。

> 【0037】次に、上記素子を2枚の偏光板〔日東電工 社製G1220DU]で鋏み、一方の偏光板の偏光透過 軸をラビング方向とはく平行、即ち、φει=85° と し、他方をこれと直交、即ち、ま。コニー5°とした。こ れによりノーマリクローズ特性の液晶表示素子を得た。

極1を形成し、上側基板3上に定査電板2を形成し、両 基板の電極間で液晶に電界を印加できるようにした。両 基板上の電極2、3は、いずれも従来のアクティブマト リクス型液晶表示装置と同様の手法で形成した帽16 μ

血のアルミニウムからなるが、電気抵抗の低いものであ れば特に材料には制約はなく、クロム、銅等でもよい。 このように低電気抵抗の金属電極を形成することにより 駆動しSIの負荷が低減され、消費電力を低減すること ができる。さらに飲乱モード等の採用により、消費電力 近い白色表示が可能であり、液晶表示装置の低消費電力

【① 039】本実施例では透明電極を用いる必要がない ため、電極のバターニング等の製造プロセスの簡略化と **歩留まりを向上することができる。特に、透明電極を形** 成するための真空炉を有する極めて高価な設備が不要で ある.

化を可能とする。

【①①40】本実施例における画案への印加湾圧実効値 と明るさの関係を示す電気光学特性を図3 (a) に示 方式(比較例1)に比べ極めて小さく。 視角を変えても 表示特性にはほとんど変化がない。また、液晶の配向性 も良好で、配向不良に基づくドメインの発生もなかっ

【① 0.4.1】 [比較例1] 従来方式であるツイステッド ネマチック(TN)型の素子の場合、ITO透明電極が 必要なため、実施例1に比べて構造が複雑でその製造工 程も多い。液晶組成物としては、ネマチック液晶の誘電 異方性Δεが正でその値が4.5。屈折率異方性Δηが 0.072 (589nm, 20℃) のものを用い、ギャ ップ?.3 μm、ツイスト角90度とした。これにより An · dtt 0.526 um ras.

【①①42】また、液晶分子は弯圧無印加時には基板面 に平行に配向しているが、電界印加時には電界に平行、 即ち、基板面に垂直に配向するため視角特性が悪い。電 気光学特性を図3(り)に示すが、視角方向の違いによ りカーブが大きく変化した。

【10043】 (実施例2) 実施例1と同様の方法で、信 号電極1と走査電極2を同一の基板上に形成した。図4 (a)に素子構造の模式断面図を、図4(h)に1回素 40 の電極構造の平面図を示す。なお、図4(り)に示すよ うに信号電極1をストライプ状とし、走査電極2に信号 電極1とほぐ平行な部分IIを設けて配置し、1 画素の大 きさは80×240μm. 信号電極1と定査電極2の間 隔を48μmとした。

【①①4.4】図4(a)において電極が形成されていい ない上側基板3にピッチ110μmのストライブ状の。 R、G、Bの3色からなる染色系カラーフィルタ11を 電着法により形成し、1ドットの大きさを90×310 µmとした。カラーフィルタ11の上には透明エポキシ 50 ントラスト比が急激に低下する。図3(a)に示す電気

樹脂からなる平坦化膜12をスピンコートレ表面を平坦 化した。 夏に、平坦化膜 12の上にはポリイミド系の配 向副御膜4を塗布した。なお、液晶表示素子には駆動し SI (図示省略) が接続されている。

Я

【10045】本実施例では、配向膜4としてPIQ(日 立化成社製)の4%溶液を用い、スピンコート後、18 ○℃で1時間焼成し、ラビング処理を行った。チルト角 を回転結晶法で測定したところ2度を得た。なお、従来 方式の液晶表示装置ではチルト角5度以上が必要であ の大きなバックライト等を用いずにペーパーホワイトに 10 り、そのためには、例えば、日産化学社製のRN422 を使用した場合250℃で1時間の競成が必要であっ た。このような200 C以上の高温プロセスでは、染色 系のカラーフィルタでは退色するため用いることができ なかった。本実施例では鏡成温度が180℃と低く染色

【① 0.4.6】また、基板3を透明ガラスの代わりにポリ カーボネート ポリエチレンテレフタレート (PE T)、ポリアクリルスルホン(PES)、アクリル樹脂 などのプラスチック基板が使用できるので、表示装置の す。視角を左右、上下に変えた場合のカーブの差は従来 20 重量を善しく軽減することができる。さらに電極を形成 しない方の基板には、プラスチック製のファイバーブレ ートやレンズアレイなど視差解消のための部材を取付け て視角特性を向上することが可能である。

系カラーフィルタでも退色の問題はなかった。

【1) () 4.7】 (実施例3) 図5は、本実施例の走査電極 と信号管極の電極バターンの平面図である。1画素の鎖 域17内に複数の電極を配置し、電界が印加される電極 間の距離を狭くした。

【10048】図5 (a)では、信号電極1と走査電極2 の間隔を24μm、同(b)では1画素の大きさ240 30 ×240μm。電極幅12μm、信号電極1と走査電極 2の間隔は24 μm、同(c)では1 画素の大きさ12 ①×240μm、電極幅5μm、信号電極1と走査電極 2の間隔を19μmとした。

【0049】上記電極1、2の間隔を1/2にすると液 温に印加される電界は2倍になり、その結果しきい値管 圧と応答時間がいずれも短縮される。なお、明るさが絵 変化量の10%変化する電圧(V.e)をしきい値電圧と 定義すると、実施例1では2.5 Vであったものが本実 施例では1.7 Vになった。

- 【0050】また、応答時間は、電圧0ボルトと明るさ が総変化量の90%変化する電圧(V.。)間でオン/オ フ(スイッチング)したところ、実施例1が650ms であったものが、本実施例では140msに短縮され た。

【0051】 (実施例4) 一般に時分割駆動の場合、走 査線数が増えるとコントラスト比が低下すると云う問題

【0052】図6は、走査線数とコントラスト比の関係 を示すグラフであるが、走査複数が50本を超えるとコ

光学特性の場合。走査複数40本ではコントラスト比1 0:1のものが得られたが、走査複数200本ではコン トラスト比は2:1程度に低下した。

【①①53】本実施例では走査複数を増さずに表示画案 数を増す方法として、図?に示すように信号回路18, 19の二系統にした多重マトリクス化(但し、一つの定 査回路の走査線数は4()本)して、表示画素数を2倍に することができる。

【0054】さらにまた、信号電極を上下2分割し、信 号回路を4系統。走査回路を4系統とすることにより、 640×40 画素を640×160 画素に拡大すること ができ、そのコントラスト比も10:1を得た。

【0055】 (実施例5) 本実施例では、さらに高コン トラスト比を維持し、表示ライン数を上げるために、基 板3の一方をセラミック (グリーンシートより作製) 基 板とし、直径15μmのスルーホール21を設け、駆動 回路と駆動用しS!20を液晶層と接しない裏面に直接 配置した。図8にスルーホールを設けた基板3の斜視図 を、図9に液晶セルの断面図を示す。

極」は液晶層に電界を印加するために配置されており、 駆動用LSI20とはスルーホール21によって接続さ れている。二重マトリクスとスルーホールにより10系 統の走査回路を設け、640×400画素の表示で、コ ントラスト比10:1を達成した。

【0057】本実施例では電極としてアルミニウムを用 い該電極を反射膜の一部と兼ねている液晶表示装置を作 製した。

【()()58】従来の反射型液晶表示装置は、液晶層を挟 待する基板の外側に酸化アルミ等の反射板6 (図1参 照)を配置していたが、本発明では高反射率を有する金 属電極を用いることができ反射膜の一部を兼ねさせるこ とができる。また、当該電極は基板の内側に配置される ために下側偏光板を省略することができる。

【0059】また、電極幅が一定の場合、画案数が多い 高精細型液晶表示装置では、一画素に占める電極の割合 が増えるため、反射膜を兼ねさせることは有効である。 さらにまた、視角が広いと云う特性から屋外の表示塔や 看板として有効である。

極1.2間に形成した電気絶縁膜13として透明ポリマ であるエポキシ樹脂に変えた。該絶繰騰13を無機膜か **ら遠明ポリマに変えたことで、成膜方法も真空製造設備** によらずにスピンコート法。印刷法等の置産性の高い成 膜方法を用いることができ、大型基板として置産性に優 れている。

【①①61】本実施例による液晶表示装置の電気光学特 性を測定したところ、図3(a)とと同様に、視角を左 右。上下に変えた場合のカーブの差が極めて小さく、表 示特性はほとんど変化がない。

【0062】 (実施例7) 従来方式では、図10に示す よろにカラーフィルタの各色間にブラックマトリクスと 呼ばれる選光領域層を印刷や蒸着で形成していた。

16

【10063】本実施例では図11に示すように電極1, 2をブラックマトリクスと策ねさせることができ、これ により選光領域層の形成工程を省略することができる。 【0064】 (実施例8) 従来方式では図12の液晶セ ルの模式断面図に示すように、二枚の墓板 3 間に球状の スペーサ(SiO、粒子)を分散させて一定のセルギャ 10 ップを得ていた。

【0065】本発明では図13に示すように電極1,2 がスペーサを兼ねることができる。特に電極1.2を一 方の基板に配置した時有効であり、図13(a)のよう に走査電極2と信号電極1との交差部はエッチングした 後、絶縁膜13をスピンコートで塗布して平坦した。ま た。図13(b)に示すように電極1.2をそれぞれの 基板に配置したものでは、上記の電極のエッチングは必 要ない。なお、本実施例では基板間ギャップは5 μmの ものを形成したが、従来の球状スペーサを用いたものに 【0056】図9において、液晶層と接する基板面の電 20 比べ、均一なセルギャップのものが得られた。

【0066】次に、液晶の表示モードについて説明をす

【0067】図14は、液晶素子の電界無印加時の液晶 分子の配向状態を示す模式断面図である。図14(a) は液晶分子は葉板面と平行配向、(b)は垂直配向、

(c)では基板面に平行で、かつ、液晶層がねじれ構造 を有する場合を示す。

【0068】図15は、液晶素子の電界印加時の液晶分 子の配向状態を示す模式断面図である。電界の印刷によ 30 り図11(a)は液晶分子は一方の基板面で平行配向、 もろ一方の基板面で垂直配向、(り)は基板間中央部で 垂直配向、(c)はランダム配向、(d)は基板間中央 部で平行配向。(e)はねじれ構造がなく基板面に平行 に配向した場合を示す。

【0069】前記実施例1~5は、図14と図15のい ずれの配向状態の組合せでも表示できる。また液晶組成 物としての誘電率異方性は正、負のいずれでもよい。 [0070]

【発明の効果】本発明によれば、表示の均一性が高く、 【0060】 (実施例6) 本実施例では、実施例2の第 40 視角特性が良好な単純マトリクス型液晶表示装置が得ち

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示装置の図である。

【図2】液晶表示装置の光学的軸の説明図である。

【図3】本発明と従来の液晶表示装置の電気光学特性を 示す図である。

【図4】本発明における別の実施例における素子構造を 示す図である。

【図5】本発明における別の実施例における電極バター 50 ンを示す平面図である。

(7) **特開平7-72491** 12

11

【図6】本発明における走査複数とコントラスト比の関係を示す図である。

【図7】本発明における液晶表示装置の駆動回路の配置 を示す図である。

【図8】本発明における別の実施例におけるスルーホールを有する基板の斜視図である。

【図9】本発明における別の実施例におけるスルーホールを有する基板からなる液晶表示装置の断面図である。

【図 1 0 】従来の液晶表示装置のカラーフィルタとブラックマトリクスの構造を示す図である。

【図11】本発明におけるカラーフィルタとブラックマトリクスの構造を示す図である。

【図12】従来の液晶表示装置のスペーサの構造を示す 図である。

【図13】本発明におけるスペーサと電極構造を示す図*

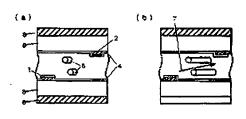
*である。

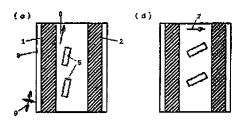
【図14】本発明における液晶表示装置の表示モードの 電界無印加時の液晶分子配向状態を示す断面図である。 【図15】本発明における液晶表示装置の表示モードの 電界印加時の液晶分子配向状態を示す断面図である。 【符号の説明】

1…信号電極、2…走査電極、3…甚板、4…配向制御 膜、5…液晶分子、6…偏光板、7…電界方向、8…ラ ピング方向、9…偏光板吸収軸方向、10…位相差板の 追相軸方向、11…カラーフィルタ、12…平坦化膜、 13…総縁膜、14…ブラックマトリクス、15… i T 〇電板、16…球状スペーサ、17…1回素の領域、1 8…第一の信号回路、19…第二の信号回路、20…飯 動用しSi、21…スルーホール。

【図1】

图 1

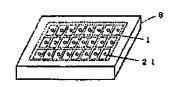




1 …信号范禄 2 …走玄電信 3 …益版 4 …配內制卸裝 5 ---激品分子 6 ---編光復 7 ---電界方向 8 ---ラビング方向

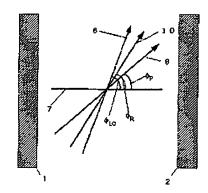
[28]

⊠ 8



[図2]

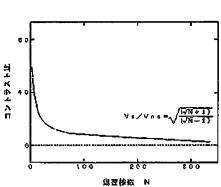
⊠ 2

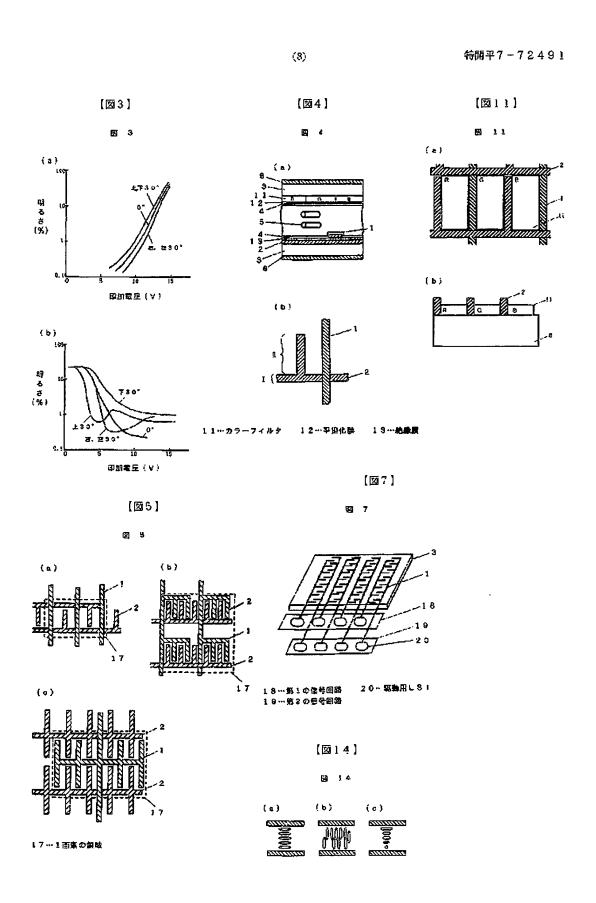


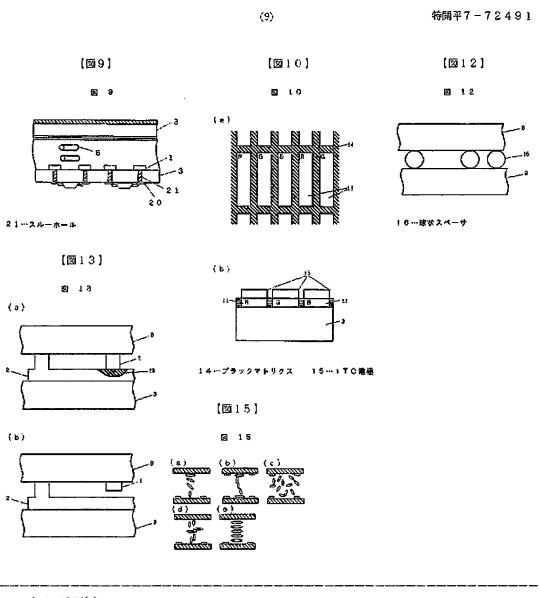
9…偏光极艰艰地方向 10… 並得差板の進相軸方向

[図6]

29 €







フロントページの続き

(72)発明者 大和田 淳一 千葉県茂原市早野 3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス享業部内 (72) 発明者 菊地 直樹 千葉県茂原市早野 3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス享業部内